一维金属-介质周期结构的自准直特性和亚波长成像*

张锦龙节刘 旭 厉以宇 李明宇 顾培夫

(浙江大学现代光学仪器国家重点实验室 杭州 310027) (2006年12月9日收到 2007年2月25日收到修改稿)

计算了一维金属-介质周期结构 1DMD 的色散曲线 利用传输矩阵法模拟了该结构对入射高斯光束的自准直 作用 着重讨论了金属层吸收的影响 对该结构在半波长厚度时近场成像特性进行了分析 ,单光源的成像分辨率为 λ/8 ,达到亚波长分辨效果 ;分辨率随着光源逐渐远离近场范围而降低.双狭缝的成像模拟进一步验证了 1DMD 结 构的近场亚波长成像能力 ,分辨率达到 λ/3.

关键词:光子晶体,自准直,亚波长成像,金属-介质层 PACC:7820,0340K

1.引 言

自准直效应是光子晶体中的一个特殊现象,假 定一高斯光束入射到光子晶体,自准直效应使原先 在空间发散的光束到了光子晶体内部成为平行光, 抑制了光束发散角. Chigrin 等人^[1]和 Chen 等人^[2] 首先对光子晶体的自准直效应进行了研究. Lin 等 人^[3]和 Li 等人^[4,5]利用不同结构光子晶体的自准直 特性和近场散射效应实现了亚波长的近场成像. Belov^[6]首先在实验上对其进行了探索,并在微波波 段取得了进展.

本文研究了一维金属-介质周期结构(1DMD)的 自准直效应,讨论了金属层吸收对自准直的影响,利 用传输矩阵法(TMM)及时域有限差分方法(FDTD) 模拟分析了该结构的亚波长成像特性,分析了不同 光源距离情况下的成像分辨率.研究表明在近场条 件下,亚波长成像的分辨率可到达 λ/3 以上.

2.1DMD 的色散曲线

图 1 表示 1DMD 结构,界面垂直于 z 轴. 介质 层和金属层厚度分别为 $d_1 = 10$ nm 和 $d_2 = 5$ nm,即 一个周期厚度为 15 nm,介质层的介电常数 $\epsilon_1 = 2$, 金属层介电常数 $\epsilon_2 = -1$,磁导率均为 1.



图 1 1DMD 结构

1DMD 结构的色散关系可表示为如下形式^[7]:

$$\cos(K_{\rm B}d) = \cosh(\alpha_1 d_1)\cos(\alpha_2 d_2) + \frac{\alpha_1^2 \varepsilon_2^2 + \alpha_2^2 \varepsilon_1^2}{2\alpha_1 \alpha_2 \varepsilon_1 \varepsilon_2} \sinh(\alpha_1 d_1) \times \sinh(\alpha_2 d_2), \qquad (1)$$

其中, $K_{\rm B}$ 为 Bloch 波矢, $d = d_1 + d_2$, $\alpha_i = \sqrt{k_x^2 - k_0^2 \varepsilon_i \mu_i}$, $k_0 = 2\pi/\lambda$, $\lambda = 600$ nm, 根据(1)式计算得到色散曲线, 如图 2 所示, 图中虚线代表自由空间的等频线.可以看到此结构 | $k_x d/\pi$ | < 0.25 时, 即对于 | k_x | < 5 k_0 范围内的频谱分量有较平滑的等频线, 可以实现自准直效应.

3. 自准直现象模拟

利用 TMM 方法对 1DMD 结构的自准直现象进行了模拟.图 2 中色散曲线为无限周期 1DMD 结构的计算结果,计算时 1DMD 结构取 40 个周期,总厚

^{*}国家重点基础研究发展规划 973)项目(批准号 2004CB19803)和国家自然科学基金(批准号 50608014)资助的课题.

[†] E-mail:williomcheung@yahoo.com.cn



图 2 1DMD 结构和自由空间的色散曲线

度 D = 600 nm,入射和出射区域均为自由空间.采 用高斯光束入射,高斯光束可表示为^[8,9]

$$E_{iy} = \int_{\infty}^{\infty} dk_x \exp[\left(k_x x + k_{iz} Z\right)\right] / (k_x), \quad (2)$$
Image definition of the set of the set

$$\oint (k_x) = \frac{g}{2\sqrt{\pi}} \exp[-g^2(k_x - k_{ix})^2/4].$$
 (3)

入射光以 $k_i = \hat{x}k_{ix} + \hat{z}k_{iz}$ 为中心,高斯光束腰 $g = 0.6\lambda$.



图 3 TMM 方法模拟的光强分布情况 (a)空气中发散的高斯光束 (b)高斯光束垂直入射 1DMD 结构的情况 (c)高斯光束 30°角入射 (d)高斯光束 60°角入射

图 3 是用 TMM 方法模拟的光强分布图. 其中 图 3 a)为高斯光在自由空间中传播的情况,可以看 到高斯光束发散严重. 图 3 b)给出了高斯光束垂直 入射到 1DMD 结构中的光强分布情况,光强由时间 平均能流密度表示,强度与灰度值一一对应,高斯光 束束腰位于 *x* = *z* = 0 处. 模拟结果显示,对于 40 个 周期,1DMD 结构也有明显的自准直效应. 图 3 (c) 和(d)分别表示高斯光束 30°和 60°角倾斜入射情况 下的自准直效果,出射光束的方向与入射光束保持 平行,入射面与出射面的强度基本相同,相比于文献 [4 **p**的情况,反射光强很小.

前面考虑的是金属层没有吸收的理想情况,在 现实中,各种各样的金属都存在一定的吸收,因此有 必要研究金属的吸收对 1DMD 结构自准直效应的 影响.

仍然取上述结构,金属层介电常数 $\epsilon_2 = -1 + i\epsilon^{\prime\prime}$,考虑垂直入射情况下,分别对不同吸收 $\epsilon^{\prime\prime}$ 值的

15

10

5

15

10

5

情况进行了模拟.图4(a)给出了 ϵ "为 0.01 0.05 和 0.1 时出射截面的光强 | \overline{S} |分布 ;作为对比 ,图 4(b)给出了无吸收情况下和在自由空间传播时出射 截面的光强分布.可以看到当 ε"达到 0.1 时出射面 光强还能达到理想情况下的 75%,并且保持了相似 的高斯光角谱分布.



图 4 (a)不同吸收情况下出射面的光强分布;(b)自由空间和无吸收时相同出射截面光强分布

4.近场亚波长成像

Belov^[10]首先提出利用 1DMD 结构实现亚波长 成像,认为 1DMD 结构的自准直效应,能将入射光 中所有的传播模和部分倏逝模分量转变为结构内部 准直的传播模,因而能在近场实现亚波长成像.

1DMD 结构为半波长整数倍,即满足 Fabry-Perot 条件时,可以减少反射¹⁰¹,提高成像质量.取结构厚 度为 20 个周期(半波长)模拟不同光源距离情况下 该结构的近场成像特性.如图 5 所示.

图 5 中给出了点光源分别距离结构前表面 30,



60 和 90 nm 的近场成像情况,点源均位于最左边,白 线代表结构的前后表面,结构前表面位于 x = 0 处. 图 5 中展示的是时间平均能流密度的值,发散的高 斯光入射到 1DMD 结构后,发生了准直效应,以一个 规则的矩形穿过结构.在出射面,光按照原来的情 况发散,继续传播.当光源距离表面较近时,出射面 的光可以认为形成了一个点像;而随着光源距离变 远,在出射面形成一个线状的源.图 6 为不同光源 距离下距离出射面后 20 nm 处截面的高斯光光强分 布,不同光源距离下半峰全宽(FWHM)分别为 75 nm ($1/8\lambda$),120 nm(0.2λ),160 nm(0.27λ),达到亚波长 成像分辨率.



图 6 不同光源距离下距离出射面 20 nm 处光强分布

为了进一步分析 1DMD 结构的近场成像能力, 用 FDTD 方法模拟了利用该结构实现双狭缝成像的 情况. 金属层采用 Drude 模型 $\epsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\Gamma)} \omega_p = 4.4398 \text{ fs}^{-1}$, Γ 为 Q 考虑无吸收的 情况), $\omega = 2\pi c/\lambda$, $\lambda = 600 \text{ nm}$. 所选物体为两个相距 120 nm 的狭缝,狭缝宽度均为 80 nm,为亚波长结 构,物面距离 1DMD 结构前表面 20 nm. 图 7 为 20 周 期 1DMD 结构的成像模拟结果,在出射面后保持了 与物相似的形状,可以实现亚波长成像,并且达到了 $\lambda/3$ 的分辨率.图 8 给出距离出射面 10 nm 处的光 强分布图.







图 8 距离出射面 10 nm 处光强分布

5.结 论

本文研究了一维金属-介质的周期结构的自准 直现象,模拟了采用有限周期的1DMD结构,可以 取得较为理想的效果;分析了金属层吸收对自准直 特性的影响,证实了在一定的制备条件下可以实现 有较好自准直效应的1DMD结构;利用传输矩阵法 和FDTD法对1DMD结构的亚波长成像特性进行了 研究,模拟了单光源和双狭缝的成像效果,显示该 结构可以达到 λ/3的分辨率.近场成像中不同结构 厚度及金属层吸收的影响在这里没有涉及,是以后 要研究的问题.

- [2] Chen C H , Sharkawy A , Pustai D M 2003 Opt . Express 11 3153
- [3] Li Z Y , Lin L L 2003 Phys. Rev. B 68 245110
- [4] Li Y Y, Gu P F, Li M Y, Zhang J L, Liu X 2006 Acta Phys. Sin.
 55 2596 (in Chinese) [厉以宇、顾培夫、李明宇、张锦龙、刘 旭 2006 物理学报 55 2596]
- [5] Li Y Y, Gu P F, Zhang J L, Li M Y, Liu X 2006 Appl. Phys. Lett. 68 151911
- [6] Belov P A , Simovski C R , Ikonen P 2005 Phys. Rev. B 71 193105
- [7] Feng S , Elson L M , Overfelt P L 2005 Opt . Express 13 4113
- [8] Kong J A , Wu B L , Zhang Y 2002 Microwave Opt. Technol. Lett. 33 136
- [9] Chen L, He S L, Shen L F 2003 Acta Phys. Sin. **52** 2386 (in Chinese)[陈 龙、何赛灵、沈林放 2003 物理学报 **52** 2386]
- [10] Belov P A, Hao Yang 2006 Phys. Rev. B 73 113110

Analysis of self-collimation and subwavelength imaging in one-dimensional metal-dielectric structure *

Zhang Jin-Long[†] Liu Xu Li Yi-Yu Li Ming-Yu Gu Pei-Fu

(State Key Laboratory for Modern Optical Instrumentation, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)
 (Received 9 December 2006; revised manuscript received 25 February 2007)

Abstract

The dispersion curve of one-dimensional metal-dielectric structure is calculated, and the finite-difference time-domain (FDTD) method is used to simulate the self-collimation in one-dimensional metal-dielectric structure, to which a Gaussian beam is incident at different angles. The influence of the dissipation of the metal layer on self-collimation is discussed. Subwavelength imaing with the one-dimensional metal-dielectric structure is also analyzed. The resolution of $\lambda/8$ is achieved for single point source when the thickness of 1DMD is equal to $\lambda/2$. The resolution will gradually degrade as the source moves beyond the near-field domain. Imaging with double slits source is also demonstrated, and a resolution of $\lambda/3$ is achieved.

Keywords : photonic crystal , self-collimation , subwavelength imaging , metal-dielertric PACC : 7820 , 0340K

^{*} Project supported by the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 2004CB19803) and the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60608014).

[†] E-mail:williomcheung@yahoo.com.cn